

Technical-News

酸素リークによる SIMS 深さ分析

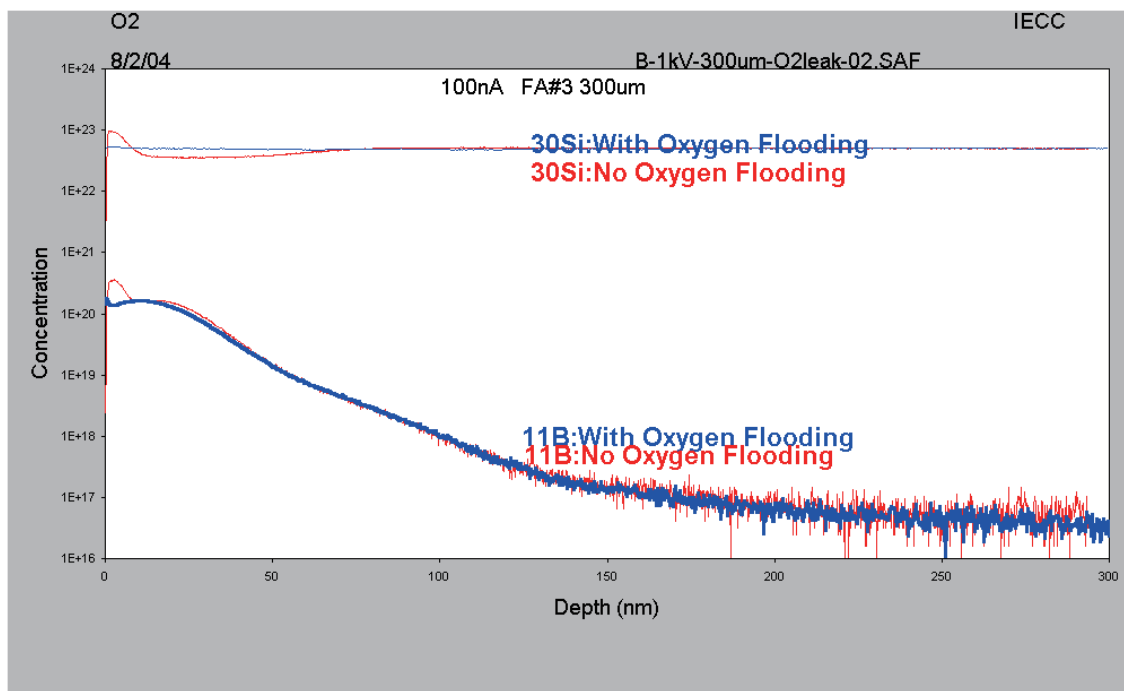
SIMS-05

株式会社イオンテクノセンター

材料開発には不純物分析が重要ですが、高感度で分析できる二次イオン質量分析 (SIMS) が最適です。

ここでは SIMS(アルバックファイ : ADEPT-1010)によってシリコンへボロンを 3keV のエネルギーでイオン注入したサンプルを分析した結果を紹介します。特に酸素リークによってボロンの深さプロファイルが正確に分析できていることがわかります。

Si への B イオン注入サンプル深さ分析



お問合せ窓口

イオンテクノセンター技術営業部
E-mail : info@iontc.co.jp

TEL:072-859-6601 / FAX:072-859-5770
URL : http://www.iontc.co.jp